

	<h2>SI2306BDS-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2306BDS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 3.16A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2306BDS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 88138 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2306BDS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.16A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	88138 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 3.16A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.16A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	47 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	305pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2306BDS-T1-GE3CT

SI2306BDS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2306BDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2306BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2306BDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2306BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.16A SOT23-3</p>	 <p>SI2306CDS-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SI2306CDS-T1-E3 VISHAY SI2306CDS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI2306DS A6SHB VISHAY VISHAY SOT-23</p>
 <p>SI2306/AO3406 UTC UTC SOT-23</p>	 <p>SI2306BDS-T1 VISHAY SI2306BDS-T1 VISHAY</p>	 <p>SI2306BDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 3.16A SOT23-3</p>	 <p>SI2306DS VISHAY SI2306DS VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

SI2304DS	SI2304DS-T1	SI2304DS-T1-E3	SI2304DS-T1-GE3	SI2305-CDS-T1-GE3
SI2305ADS-T1-E3	SI2305ADS-T1-E3	SI2305ADS-T1-GE3	SI2305ADS-T1-GE3	SI2305BDS-T1-E3
SI2305BDS-T1-GE3	SI2305CDS-T1-E3	SI2305CDS-T1-GE3	SI2305CDS-T1-GE3	SI2305DS
SI2305DS-E3	SI2305DS-T1	SI2305DS-T1-E3	SI2305DS-T1-E3	SI2305DS-T1-GE3
SI2305WCB	SI2306BDS	SI2306BDS-T1	SI2306BDS-T1-E3	SI2306BDS-T1-E3
SI2306BDS-T1-GE3	SI2306CDS-T1-E3	SI2306DS	SI2306DS-T1	SI2306DS-T1-E3
SI2306DS-T1-GE3	SI2306WCA	SI2307BDS	SI2307BDS-T1-E3	SI2307BDS-T1-E3
SI2307BDS-T1-GE3	SI2307BDS-T1-GE3	SI2307CDS	SI2307CDS-T1-E3	SI2307CDS-T1-E3
SI2307CDS-T1-GE3	SI2307CDS-T1-GE3	SI2307DS	SI2307DS-T1	SI2307DS-T1-E3
SI2307DS-T1-GE3	SI2307DS-T7-E3	SI2308BDS	SI2308BDS-T1-E3	SI2308BDS-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited